Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОНИКЕ, СПИНТРОНИКЕ И ФОТОНИКЕ КАФЕДРА ФИЗИКИ МИКРО- И НАНОСИСТЕМ

ОДОБРЕНО НТС ИНТЭЛ

Протокол № 4

от 23.07.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИКА МИКРО- И НАНОСИСТЕМ (ЧАСТЬ 1)

Направление подготовки (специальность)

[1] 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
7	3	108	24	24	0		24	0	Э
Итого	3	108	24	24	0	0	24	0	

АННОТАЦИЯ

Учебная задача курса - дать основные представления о физических процессах, происходящих в микро- и наносистемах различной размерности.

Курс состоит из следующих основных частей: квантование энергетических уровней в одномерных потенциальных ямах, эффект размерного квантования, - современные методы получения наноструктур, методы диагностики и характеризации наноструктур, применение наноструктур

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины является получение знаний, необходимых для успешной профессиональной деятельности в области исследований, разработок и технологий, направленных на создание функционализированных нано- и микрообъектов, понимание процессов, происходящих области нанофотоники, физики нанообъектов и конденсированного состояния вещества и управление процессами на наноуровне.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Программа подготовки нацелена на изучение физики микро-и наносистем, включающей физику твердого тела, ядерную физику, нанофотонику, физику органических и биоорганических наносистем, компьютерные методы моделирования наноструктур, специальных аналитических систем детектирования.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции Код и наименование	индикатора достижения компетенции
---	-----------------------------------

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	научно-иссл	педовательский	
математическое	электронные	ПК-8.1 [1] - Способен	3-ПК-8.1[1] - законы и
моделирование	приборы,	применять методы и	экспериментальные
электронных приборов,	устройства,	концепции	методы физики
схем и устройств	установки, методы	экспериментальной	конденсированного
различного	их исследования,	физики	состояния вещества,
функционального	математические	конденсированного	лазерной физики,

~	T		1
назначения на базе	модели	состояния вещества,	физики микро- и
стандартных пакетов		лазерной физики,	наносистем, принципы
автоматизированного		фотоники, физики	функционирования
проектирования;		микро- и наносистем	элементов и устройств
участие в		для решения	фотоники и
планировании и		технических,	оптоэлектроники;
проведении		технологических и	У-ПК-8.1[1] -
экспериментов по		функциональных	анализировать научно-
заданной методике,		проблем при создании	техническую
обработка результатов		и эксплуатации	проблему,
с применением		элементов и устройств,	поставленную задачу в
современных		функционирующих на	области
информационных		принципах	нанофотоники, физики
технологий и		наноэлектроники и	конденсированного
технических средств;		нанофотоники	состояния вещества,
анализ научно-			физики наноструктур,
технической		Основание:	используя
информации,		Профессиональный	отечественный и
отечественного и		стандарт: 40.011	зарубежный опыт, а
зарубежного опыта по		_	также предлагать
тематике			возможные пути ее
исследования; участие			решения;
в подготовке и подаче			В-ПК-8.1[1] -
заявок по			навыками
перспективным			экспериментальной
проектам, грантам в			работы на
рамках проводимых			специализированном
открытых конкурсов			научном
			оборудовании и
			устройствах в области
			фотоники, физики
			наноструктур,
			лазерной физики,
			опто- и
			наноэлектроники,
			математического
			моделирования
			процессов и объектов
			применительно к
			поставленной задаче
математическое	электронные	ПК-8.3 [1] - Способен	3-ПК-8.3[1] -
моделирование	приборы,	определять условия и	современные
электронных приборов,	устройства,	границы применения	технологии и методы
схем и устройств	установки, методы	существующего	физики микро- и
различного	их исследования,	исследовательского и	наносистем,
функционального	математические	технологического	нанофотоники,
назначения на базе	модели	оборудования при	нанофотоники,
стандартных пакетов	модоли	разработке устройств	применительно к
		нанофотоники, опто- и	разработке новых
автоматизированного проектирования;		нанофотоники, опто- и наноэлектроники и	устройств в
		-	предметной области;
участие в		усовершенствовать	-
планировании и		действующие методы	У-ПК-8.3[1] -

проведении экспериментов по заданной методике, обработка результатов с применением современных информационных технологий и технических средств; анализ научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; участие в подготовке и подаче заявок по перспективным проектам, грантам в рамках проводимых открытых конкурсов

исследования наноструктур

Основание:

Профессиональный стандарт: 40.104

применять теоретические знания, методы и концепции физики конденсированных сред, физики микро- и наносистем, фотоники в части решения задач нанофотоники, нано- и оптоэлектроники; В-ПК-8.3[1] навыками работы на исследовательском и технологическом оборудовании, применяемом при создании и исследовании параметров приборов на основе принципов фотоники, нанофотоники и оптоэлектроники

производственно-технологический

внедрение результатов исследований и разработок в производство; выполнение работ по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники; проведение технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники; контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов энерго - и ресурсосбережения; подготовка документации и участие в работе системы менеджмента качества на

предприятии;

материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки, методы их исследования, проектирования и конструирования, технологические процессы производства, диагностическое и технологическое оборудование, алгоритмы решения типовых задач

ПК-10 [1] - Способен к модернизации существующих и внедрению новых методов и оборудования для измерений параметров наноматериалов и наноструктур

Основание: Профессиональный стандарт: 29.007

3-ПК-10[1] - Знание физических основ современных микро- и нанотехнологий, технологий гетероструктурной и СВЧ-электроники.; У-ПК-10[1] - Умение творчески применять современное оборудование для измерений параметров наноматериалов и наноструктур; В-ПК-10[1] - Владение методами измерений параметров наноматериалов и наноструктур

организация		
метрологического		
обеспечения		
производства		
материалов и изделий		
электронной техники		

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал
воспитания Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование ответственности за профессиональный выбор, профессиональное развитие и профессиональные решения (В18)	дисциплин Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования у студентов ответственности за свое профессиональное развитие посредством выбора студентами индивидуальных образовательных траекторий, организации системы общения между всеми участниками образовательного процесса, в
		том числе с использованием новых информационных технологий.
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование научного мировоззрения, культуры поиска нестандартных научнотехнических/практических решений, критического отношения к исследованиям лженаучного толка (В19)	1.Использование воспитательного потенциала дисциплин/практик «Научно-исследовательская работа», «Проектная практика», «Научный семинар» для: - формирования понимания основных принципов и способов научного познания мира, развития исследовательских качеств студентов посредством их вовлечения в исследовательские проекты по областям научных исследований. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин "История науки и инженерии", "Критическое мышление и основы научной коммуникации", "Введение в специальность", "Научноисследовательская работа", "Научный семинар" для: - формирования способности отделять настоящие научные

Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование навыков коммуникации, командной работы и лидерства (В20)	исследования от лженаучных посредством проведения со студентами занятий и регулярных бесед; - формирования критического мышления, умения рассматривать различные исследования с экспертной позиции посредством обсуждения со студентами современных исследований, исторических предпосылок появления тех или иных открытий и теорий. 1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для развития навыков коммуникации, командной работы и лидерства, творческого инженерного мышления, стремления следовать в профессиональной деятельности нормам поведения, обеспечивающим нравственный характер трудовой деятельности и неслужебного поведения, ответственности за принятые решения через подготовку групповых курсовых работ и практических заданий, решение кейсов, прохождение практик и подготовку ВКР.
		решения через подготовку групповых курсовых работ и практических заданий, решение кейсов, прохождение практик и
		модельных, так и практических задач, а также путем подкрепление рациональнотехнологических навыков взаимодействия в проектной деятельности эмоциональным эффектом успешного взаимодействия, ощущением роста общей эффективности при распределении проектных задач в соответствии с

		ANTH W 10 M 10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
		сильными компетентностными
		и эмоциональными свойствами
П 1	Canadana	членов проектной группы.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование
воспитание	обеспечивающих, формирование	воспитательного потенциала
	творческого	дисциплин профессионального
	инженерного/профессионального	модуля для развития навыков
	мышления, навыков организации	коммуникации, командной
	коллективной проектной	работы и лидерства,
	деятельности (В22)	творческого инженерного
		мышления, стремления
		следовать в профессиональной
		деятельности нормам
		поведения, обеспечивающим
		нравственный характер
		трудовой деятельности и
		неслужебного поведения,
		ответственности за принятые
		решения через подготовку
		групповых курсовых работ и
		практических заданий, решение
		кейсов, прохождение практик и
		подготовку ВКР.
		2.Использование
		воспитательного потенциала
		дисциплин профессионального
		модуля для: - формирования
		производственного
		коллективизма в ходе
		совместного решения как
		модельных, так и практических
		задач, а также путем
		подкрепление рационально-
		технологических навыков
		взаимодействия в проектной
		деятельности эмоциональным
		эффектом успешного
		взаимодействия, ощущением
		роста общей эффективности
		при распределении проектных
		задач в соответствии с
		сильными компетентностными
		и эмоциональными свойствами
H 1		членов проектной группы.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование
воспитание	обеспечивающих, формирование	воспитательного потенциала
	коммуникативных навыков в	профильных дисциплин
	области разработки и производства	«Введение в специальность»,
	полупроводниковых изделий (ВЗ6)	«Введение в технику
		физического эксперимента»,
		«Измерения в микро- и
		наноэлектронике»,

«Информационные технологии в физических исследованиях», «Экспериментальная учебноисследовательская работа» для: - формирования навыков безусловного выполнения всех норм безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин «Спецпрактикум по физике наносистем», «Спецпрактикум по нанотехнологиям», «Специальный практикум по физике наносистем», «Современные проблемы физики конденсированных сред (спецсеминар)», «Экспериментальные методы исследования наноструктур (спецсеминар)», для: формирования профессиональной коммуникации в научной среде;

- формирования разностороннего мышления и тренировки готовности к работе в профессиональной и социальной средах полупроводниковой промышленности формирования умений осуществлять самоанализ, осмысливать собственные профессиональные и личностные возможности для саморазвития и самообразования, в целях постоянного соответствия требованиям к эффективным и прогрессивным специалистом для разработок новых материалов и устройств по направлениям, связанным с СВЧ электроникой, микро- и нанопроцессорами, оптическими модуляторами и применением новых материалов в наноэлектронных компонентах через организацию практикумов в организациях по разработке и производству полупроводниковых изделий, использование методов коллективных форм познавательной деятельности, ролевых заданий, командного выполнения учебных заданий и защиту их результатов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	едели	екции/ Практ. семинары)/ Габораторные аботы, час.	онтроль (форма*, еделя)	Гаксимальный алл за раздел**	ттестация аздела (форма*, еделя)	Индикаторы освоения компетенции
		H		О КО Не	S Z	A ₁ pa He	И 00 КО

	7 Семестр					
1	Раздел 1	1-8	12/12/0	25	КИ-8	3-ПК-8.1,
						У-ПК-8.1,
						В-ПК-8.1,
						3-ПК-8.3,
						У-ПК-8.3,
						В-ПК-8.3
2	Раздел 2	9-16	12/12/0	25	КИ-16	3-ПК-10,
						У-ПК-10,
						В-ПК-10
	Итого за 7 Семестр		24/24/0	50		
	Контрольные			50	Э	3-ПК-8.1,
	мероприятия за 7					У-ПК-8.1,
	Семестр					В-ПК-8.1,
						3-ПК-8.3,
						У-ПК-8.3,
						В-ПК-8.3,
						3-ПК-10,
						У-ПК-10,
						В-ПК-10

^{* –} сокращенное наименование формы контроля

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
КИ	Контроль по итогам
Э	Экзамен

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек.,	Пр./сем.,	Лаб.,
		час.	час.	час.
	7 Семестр	24	24	0
1-8	Раздел 1	12	12	0
1	Тема 1	Всего а	удиторных	часов
	Длина волны Де Бройля. Эффект размерного квантовая,	2	2	0
	классификация наноструктур. Основные понятия физики	Онлайн	I	
	твердого тела. Кристаллическая структура, элементарная	0	0	0
	ячейка, понятие об обратной решетке.			
2	Тема 2	Всего а	удиторных	часов
	Основные понятия физики твердого тела. Уравнение	2	2	0
	Шреденгера в одноэлектронном приближении. Теорема	Онлайн	I	
	Блоха. Энергетические зоны в кристалле и классификация	0	0	0
	веществ по типу проводимости (металл, полупроводник,			
	диэлектрик). Модель сильной связи.			
3	Тема 3	Всего а	удиторных	часов
	Основные понятия физики твердого тела. Понятие дырки.	2	2	0
	Эффективная масса. Физический смысл эффективной	Онлайн	ī	

^{**} – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

	X7			
	массы. Уравнение движения электрона во внешнем	0	0	0
	электрическом поле. Основные понятия физики твердого			
	тела. Заполнение энергетических зон. Функция			
	распределения и плотность состояний и функции			
	распределения в 3D случае. Уровень ферми в металле и			
	полупроводнике. Собственные и примесные			
	полупроводники.			
4	Тема 4	Всего	аудиторны	х часов
	Гетеропереход. Понятие гетероперехода, типы	3	3	0
	гетеропереходов. Условия сшивки волновой функции на		-	, ,
	гетерогранице. Уравнение для огибающей волновой	Онлай	0	0
	функции. Искажение зонной структуры вблизи			U
	гетерограниц. Область объемного заряда, ее масштаб.			
	Энергетический спектр электронов прямоугольной			
	потенциальной яме различной размерности.	D		
5	Тема 5		аудиторны	
	Энергетический спектр в цилиндрической и сферической	3	3	0
	потенциальных ямах. Экситоны в наноструктурах.	Онлай	1	
	Плотность состояний в системах пониженной размерности	0	0	0
	(2D, 1D, 0D случаи).			
9-16	Раздел 2	12	12	0
6	Тема 6	Всего	аудиторны	х часов
	Сверхрешетки. Особенности энергетического спектра.	2	2	0
	Метод сильной связи. Задача Кронига-Пенни. Некоторые	Онлай	Н	- II.
	методы исследования наноструктур. Электронная и	0	0	0
	атомно-силовая микроскопия. Основы технологии			
	создания наноструктур. Молекулярно-лучевая эпитсаксия,			
	газофазная эпитаксия, литография.			
7	Тема 7	Всего	⊥аудиторны	у пасов
,		2	<u>аудиторны</u> 2	0
	Поглощение и испускание света полупроводниками. Пямозонные и непрямозонные полупроводники.			U
			Н	
	<u> </u>	0	0	0
8	Тема 8 Использование гетероструктур в технологии полупроводниковых лазеров.		аудиторны	
			2	0
			Н	
		0	0	0
9	Тема 9		аудиторны	х часов
·	Применение полупроводниковых наноструктур		$\frac{1}{2}$	0
	микроэлектронике. Использование гетероструктур в	2 Онлай	. =	
	технологии фотодетекторов. Фотодетекторы ИК диапазона	0	0	0
	на множественных квантовых ямах.		U	
10	Тема 10	Reare		V HOCOR
10		2	аудиторны 2	
	Применение полупроводниковых наноструктур микроэлектронике. Резонансное туннелированные.		2	0
			H	
		0	0	0
11	Тема 11		аудиторны	х часов
	Применение полупроводниковых наноструктур	2	2	0
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	микроэлектронике. Полевые транзисторы. Транзистор с	Онлай	Н	

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
BM	Видео-материалы
AM	Аудио-материалы
Прз	Презентации
T	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Недели	Темы занятий / Содержание
	7 Семестр
	Тема1
	Длина волны Де Бройля. Эффект размерного квантовая, классификация наноструктур.
	Основные понятия физики твердого тела. Кристаллическая структура, элементарная
	ячейка, понятие об обратной решетке.
	Тема2
	Основные понятия физики твердого тела. Уравнение Шреденгера в одноэлектронном
	приближении. Теорема Блоха. Энергетические зоны в кристалле и классификация
	веществ по типу проводимости (металл, полупроводник, диэлектрик). Модель
	сильной связи.
	Тема3
	Основные понятия физики твердого тела. Понятие дырки. Эффективная масса.
	Физический смысл эффективной массы. Уравнение движения электрона во внешнем
	электрическом поле. Основные понятия физики твердого тела. Заполнение энергетических зон. Функция распределения и плотность состояний и функции
	распределения в 3D случае. Уровень ферми в металле и полупроводнике.
	Собственные и примесные полупроводники.
	Тема4
	Гетеропереход. Понятие гетероперехода, типы гетеропереходов. Условия сшивки
	волновой функции на гетерогранице. Уравнение для огибающей волновой функции.
	Искажение зонной структуры вблизи гетерограниц. Область объемного заряда, ее
	масштаб. Энергетический спектр электронов прямоугольной потенциальной яме
	различной размерности.
	Тема5
	Энергетический спектр в цилиндрической и сферической потенциальных ямах.
	Экситоны в наноструктурах. Плотность состояний в системах пониженной
	размерности (2D, 1D, 0D случаи).
	Тема6
	Сверхрешетки. Особенности энергетического спектра. Метод сильной связи. Задача
	Кронига-Пенни. Некоторые методы исследования наноструктур. Электронная и
	атомно-силовая микроскопия. Основы технологии создания наноструктур.
	Молекулярно-лучевая эпитсаксия, газофазная эпитаксия, литография.
	Тема7
	Поглощение и испускание света полупроводниками. Пямозонные и непрямозонные
	полупроводники. Тема8
	Использование гетероструктур в технологии полупроводниковых лазеров.
L	пенользование тетероструктур в технологии полупроводниковых лазеров.

Тема9
Применение полупроводниковых наноструктур микроэлектронике. Использование
гетероструктур в технологии фотодетекторов. Фотодетекторы ИК диапазона на
множественных квантовых ямах.
Тема10
Применение полупроводниковых наноструктур микроэлектронике. Резонансное
туннелированные.
Тема11
Применение полупроводниковых наноструктур микроэлектронике. Полевые
транзисторы. Транзистор с плавающим затвором.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При проведении лекций используются наглядные формы демонстрации учебного материала в виде презентаций, а также выступление ученых, занимающихся исследованиями в области физики микро- и наносистем. Студенты в обязательном порядке посещают лекции ведущих мировых ученых на тему физики наносистем. Проведение семинаров предусматривает проведение дискуссий и выступления студентов с докладами на темы, связанные с физикой и технологией наносистем.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие
		(КП 1)
ПК-10	3-ПК-10	Э, КИ-16
	У-ПК-10	Э, КИ-16
	В-ПК-10	Э, КИ-16
ПК-8.1	3-ПК-8.1	Э, КИ-8
	У-ПК-8.1	Э, КИ-8
	В-ПК-8.1	Э, КИ-8
ПК-8.3	3-ПК-8.3	Э, КИ-8
	У-ПК-8.3	Э, КИ-8
	В-ПК-8.3	Э, КИ-8

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех	Оценка	Требования к уровню освоению
	балльной шкале	ECTS	учебной дисциплины
90-100	5 — «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89		В	Оценка «хорошо» выставляется студенту,
75-84	1	С	если он твёрдо знает материал, грамотно и
70-74	4 – «хорошо»	D	по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
65-69			Оценка «удовлетворительно»
60-64	3 — «удовлетворительно»	Е	выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
Ниже 60	2 — «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. ЭИ П 85 Наноматериалы и нанотехнологии : учебное пособие, Ганзуленко О. Ю. [и др.], Санкт-Петербург: Лань, 2022
- 2. ЭИ К 49 Наноплазмоника: учебное пособие, Климов В. В., Москва: Физматлит, 2010
- 3. 537 3-43 Принципы лазеров : , Звелто О., Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008
- 4. 620 Д93 Углеродные нанотрубки : строение, свойства, применения, Дьячков П.Н., Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2006
- 5. ЭИ Ш 18 Физика полупроводников : учебное пособие, Шалимова К. В., Санкт-Петербург: Лань, 2022
- 6. ЭИ П 49 Физико-химические основы нанотехнологий : учебник, Поленов Ю. В., Егорова Е. В., Санкт-Петербург: Лань, 2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. 539.2 К45 Введение в физику твердого тела:, Киттель Ч., М.: МедиаСтар, 2006
- 2. 541.5 Т88 Молекулярная фотохимия: , Турро Н., Москва: Мир, 1967

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1. Образцы фотонных кристаллов (Э-205)
- 2. Образцы пористого кремния (Э-205)
- 3. Образцы полупроводниковых коллоидных квантовых точек (Э-205)
- 4. Демонстрационный проектор

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

При изучении курса студент должен освоить основные знания о строении, энергетической структуре и оптических свойствах полупроводниковых, органических и металлических нано- и микроструктур, а также иметь представление о методах создания наноструктур и областях их практического применения.

Курс рассчитан на два семестра. Темы первого семестра в основной свой массе посвящены изучению общих сведений о строении и энергетической структуре нано- и микро систем. Темы второго семестра более подробно знакомят студентов с конкретными классами нанообъектов и специфическими свойствами.

При изучении тем 1-5 студент должен познакомиться с классом углеродных наноструктур. Иметь четкое представление о структуре УНТ, фуллеренов и графена, методах их получения и областях практического применения. Знать определение молекулярной орбитали и основных приближений положенных в основу метода ЛКАО. Овладеть основами расчета энергетической структуры УНТ различной хиральности. В качестве самостоятельной работы - решать задачи предложенные преподавателем.

В результате изучения темы 6 студент должен познакомиться с понятием пористых наноструктур в частности с пористым кремнием (ПК). Студенту следует усвоить основные свойства ПК, иметь четкое представление о методах его изготовления и природе его люминесценции. В качестве самостоятельной работы - решать задачи предложенные преподавателем.

При изучении тем 7-9 студент должен четко усвоить понятия фотонного кристалла, Брэгговской решетки и микрорезонатора. Также следует обратить особое внимание на понимание таких понятий как запрещенная фотоная зона и плотность фотонных состояний. С практической точки зрения студент должен освоить методы расчет отражения и пропускания многослойной структуры с использованием метода матрицы передачи. В качестве самостоятельной работы - решать задачи предложенные преподавателем.

Тема 10 посвящена процессам переноса энергии на наномасштабе. При ее изучении студент должен усвоить понятия излучательного и безызлучательного переноса энергии. Понимать природу и условия протекания механизмов переноса энергии по Ферстеру и по Декстеру. Знать примеры практического использования перечисленных явлений. В качестве самостоятельной работы - решать задачи предложенные преподавателем.

В результате изучения темы 11 студент должен иметь четкое представление о методах получения коллоидных полупроводниковых квантовых точек (КТ) их структуре и энергетическом спектре. Уметь оценивать длину волны излучения КТ, зная их размер и вещество из которого они синтезированы. Знать примеры практического применения КТ. В качестве самостоятельной работы - решать задачи предложенные преподавателем.

В результате изучения темы 12 студент должен иметь четкое представление о явлении плазмонного резонанса. Знать классификацию плазмонов и иметь четкое представление об оптических свойствах металлических нанокристаллов. В качестве самостоятельной работы решать задачи предложенные преподавателем.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

При изложении первого раздела необходимо учитывать, что основные принципы квантовой механики студентами 3- го курса усваиваются обычно достаточно формально. Поэтому необходимо повторение в общих чертах принципов квантовой механик: операторов физических величин, принципа неопределенности, уравнения Шредингера. С методами решения уравнения Шредингера для одномерных потенциальных ям студенты знакомы достаточно хорошо. Поэтому этот раздел можно дать для самостоятельной проработке или в форме задач. Основное внимание нужно уделить физическим выводам из решения квантовомеханических уравнений. При этом важным является вопрос: при каких размерах наноструктур и температурах экспериментально проявляется эффект размерного квантования. Этот вопрос можно оформить в виде задачи, но нужно помнить, что ее решение возможно только с помощью преподавателя. Часть занятия интересно посвятить сферической потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Это – модель полупроводниковой сферической квантовой точки. Полномерное решение уравнения Шредингера для этого случая на 3-м курсе – невозможно, поскольку студенты не знакомы со специальными функциями. Решение возможно лишь для частного случая. Однако полезно познакомить студента с поведением частицы в центральном поле, где сохраняется момент количества движения, рассмотреть уравнения для квадрата момента, закон квантования момента и его проекции на произвольную ось.

Второй раздел посвящен изложению современных методов получения наноструктур. Здесь необходимо рассмотреть методы коллоидной химии, молекулярно-лучевой эпитаксии и др. Однако, с методической точки зрения особое место занимает метод термического напыления. Действительно, изложение этого метода позволяет вспомнить и существенно дополнить знания студента по вакуумной технике. Знания по молекулярной физике в объеме

курса общей физики позволяет студентам решать задачи, которые достаточно глубоко проясняют сущность метода и позволяют провести практически важные оценки и расчеты. Здесь уместно познакомить студентов с методом лазерного напыления, который активно развивается в современной науке. Отдельного рассмотрения требуют методы получения наночастиц со свойствами плазмонного резонанса. Эффекты плазмонного резонанса можно изложить на основании элементарной теории дисперсии для плазмы.

Методы диагностики и характеризации наноструктур. Этот раздел дает возможность познакомить студентов с современной микроскопией, - электронной и атомно-силовой. При изложении метода интерференционной микроскопии полезно вспомнить общие принципы оптической интерферометрии, устройства наиболее популярных интерферометров. В этом разделе следует изложить пьезоэффект, который не рассматривается достаточно подробно ни в курсе общей физики, ни в физике твердого тела. На основе этих знаний можно излагать технику микроподач в интерферометрии, атомно-силовой микроскопии, лазерной техники.

Последний раздел курса — применение наноструктур. Рекомендуется его тесно увязать с другими курсами, которые читаются на кафедре. Например, можно подробно изложить применения полупроводниковых квантовых точек в современной органической оптоэлектронике, при разработке фотовольтаических элементов и светодиодов, а также в медицинской диагностике. Важно также рассмотреть применения наноструктур в современных методах анализа, при разработке сенсоров и т.п.

Самостоятельная работа студентов включает решение задач, предложенных преподавателем на лекциях.

Автор(ы):

Мартынов Игорь Леонидович, к.ф.-м.н.